§ 5 电场强度与电势的微分关系

1. 等势面

空间电势相等点的集合所成曲面称为等势面。为了描述空间电势的分布,规定任意两相邻等势面间的电势差相等。

▲ 在静电场中,电荷沿等势面移动时,电场力做功;

$$A_{ab} = q_0(U_a - U_b) = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

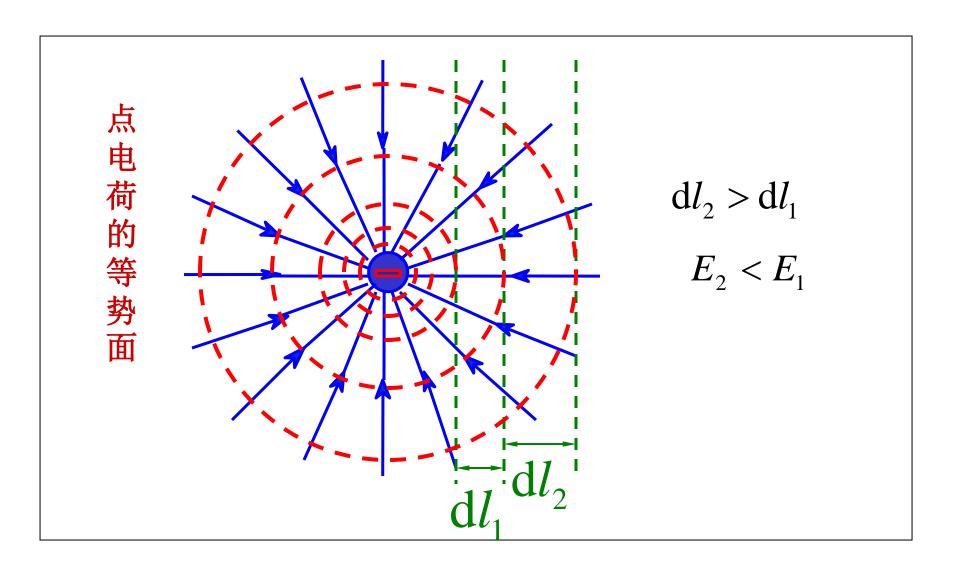
 \bot 在静电场中,电场强度 \vec{E} 总是与等势面垂直的,即电场线是和等势面正交的曲线簇;

$$A_{ab} = \int_{a}^{b} q_{0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

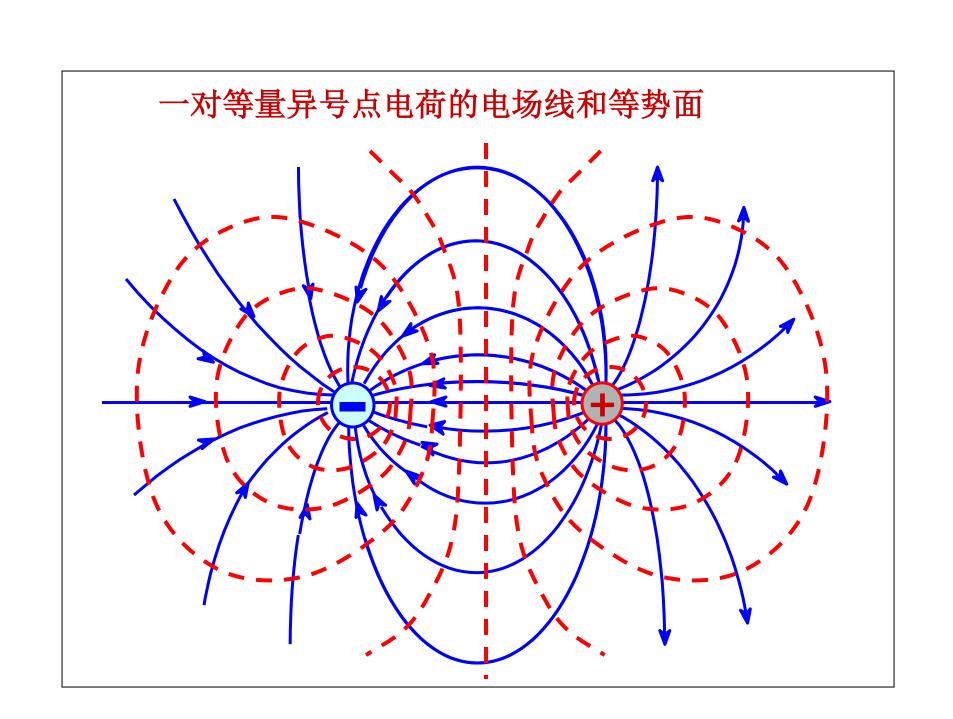
\(\therefore\) \(q_{0} \neq 0, \quad \vec{E} \neq 0, \quad d\vec{l} \neq 0

$$\vec{E} \perp d\vec{l}$$

♣ 规定: 电场中任意两相邻等势面之间的电势差相等, 即等势面的疏密程度同样可以表示场强的大小。



两平行带电平板的电场线和等势面



2. 电场强度与电势的微分关系

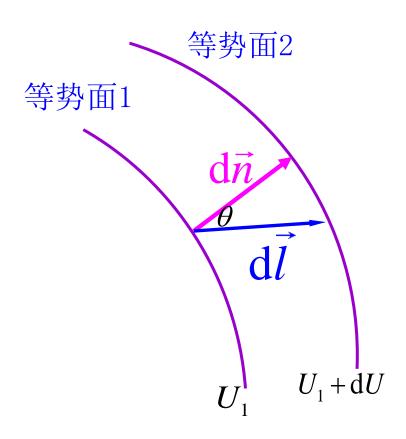
 $d\vec{n}$ 的正向为电势增加的方向。

$$: U_1 - (U_1 + dU) = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$:: (U_1 + dU) - U_1 = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$=-E dl \cos \theta$$

$$\therefore dU = -E dl \cos \theta = -\vec{E} \cdot dl$$



$$\therefore dU = -E dl \cos \theta = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

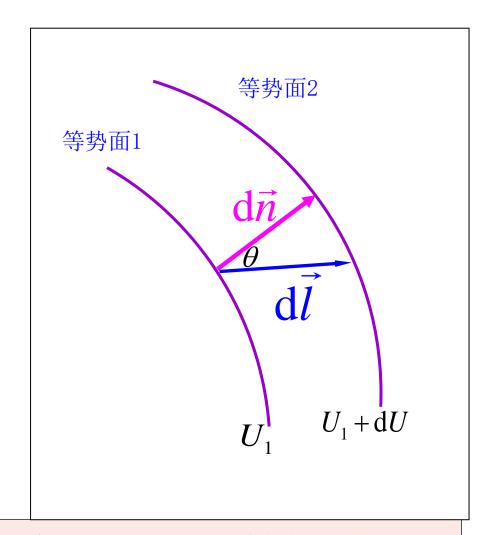
$$\therefore dl \cos \theta = dn$$

$$\therefore dU = -E dn$$

$$\therefore E = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}n}$$

即:
$$\vec{E} = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}n}\vec{n}_0$$

或:
$$\vec{E} = -\nabla U$$



-静电场中某点的<mark>电场强度</mark>等于该点的电势梯度的负值。

说明:

- (1) 空间某点电场强度的大小取决于该点邻域内电势 II 的 空间变化率。
 - (2) 电场强度的方向恒指向电势减小的方向。
 - ▲ 直角坐标系中

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right) = -\text{grad } U$$

$$\vec{E} = -\nabla U$$

(3) 电场线与等势面处处正交。

(即:在等势面上移动电荷,电场力不做功。)

(4) 等势面密处电场强度大; 等势面疏处电场强度小。

例: 求一均匀带电细圆环轴线上任一点的电场强度。

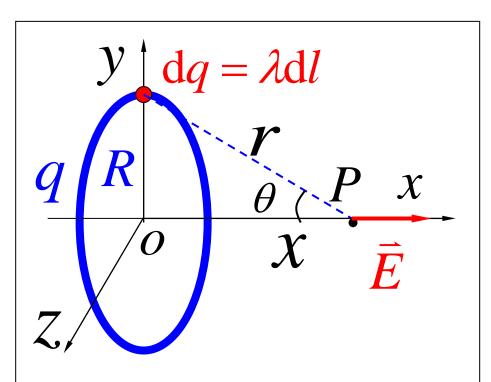
解:
$$\vec{E} = -\nabla U$$

$$U = \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$E = E_{x} = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{1/2}} \right]$$

$$=\frac{qx}{4\pi \ \varepsilon_0 (x^2+R^2)^{3/2}}$$



梯度(Gradient)、散度(Divergence)和 旋度(Curl)

矢量函数E的散度定义为:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

矢量函数E的旋度定义为:

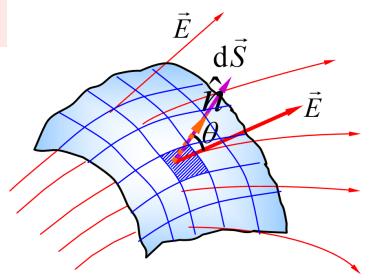
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix}$$

电场的散度 (Divergence) $\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{E}$

电场的散度代表了电场在某一点的发散程度。 更形象一点, 散度描述的是电场里一个点是汇聚点还是发源点,或者说,包 含这一点的一个微小体元中的电场线是"向外"居多还是"向 内"居多。

$$\Phi_{e} = \oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_{\Delta V} \overrightarrow{\nabla} \cdot \vec{E} dV = \frac{Q}{\varepsilon_{0}}$$

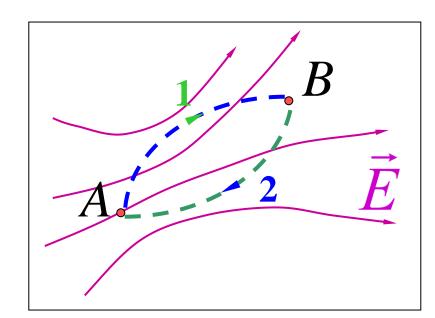
$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{E} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$



电场的旋度(curl) $\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E}$

我们可以想象河水的水流绕着一点旋转——漩涡。在漩涡范围内,水流围绕某一点旋转,我们就可以说在这个范围内,水流的旋度大于零。若水流没有绕某一点旋转的趋势,那么旋度就等于零。物理上,电场的旋度也代表了电场在某一闭合回路内的旋转程度,对于静电场而言,我们有:

$$\oint \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} = \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E} = 0$$



静电场的性质:

积分形式

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

微分形式

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

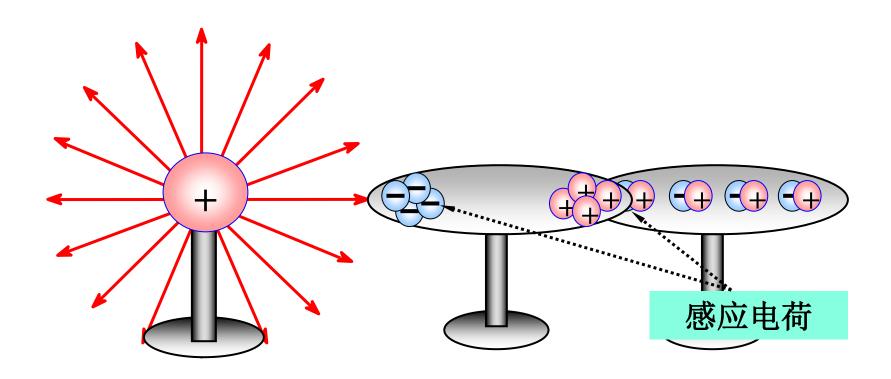
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

§ 6 静电场中的导体 电容

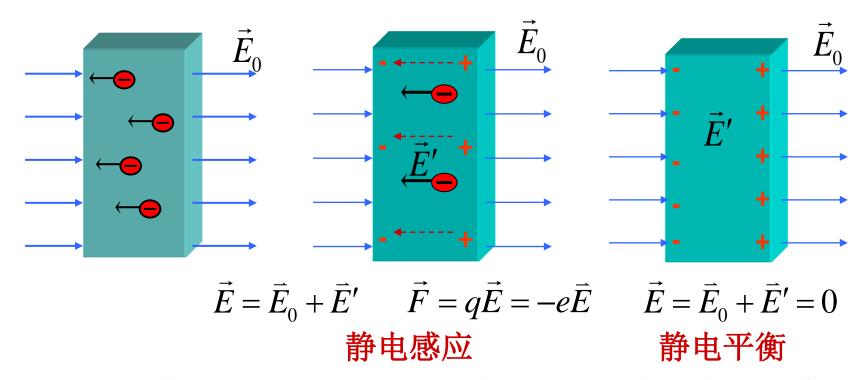
- 一、静电感应 静电平衡条件
- 1. 静电感应



2. 静电平衡

导体的特点: 有可以移动的自由电子。

导体在电场中,自由电子就要受到电场力而运动,这就改变了导体上原来的电荷分布。



导体的静电平衡状态:导体的内部和表面都没有电荷作任何宏观定向运动的状态.

静电平衡条件

- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零;
- (2) 导体表面处的电场强度的方向,都与导体表面垂直。

推论:

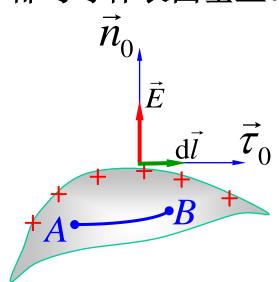
- ——导体是等势体
- > 导体表面是等势面

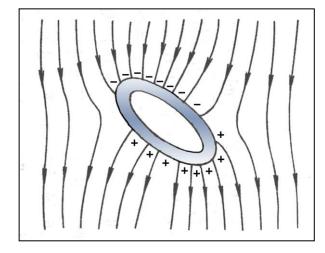
$$:: \vec{E} \perp d\vec{l}$$

$$\therefore dU = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

> 导体内各处电势相等

$$U_{AB} = \int_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$





二、静电平衡时导体上电荷的分布

1. 实心导体

$$\therefore \vec{E} = 0 \qquad \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i} q_{i}$$

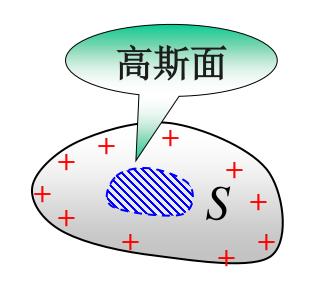
$$\therefore \sum_{i} q_{i} = 0$$

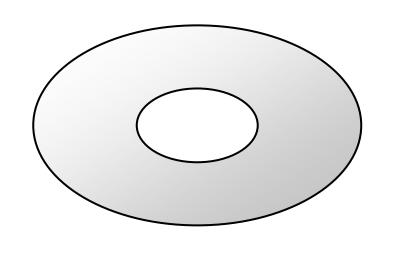
结论: 导体内部无电荷



▲ 空腔内无电荷

电荷只能分布在空腔的外表面上(内表面无电荷)





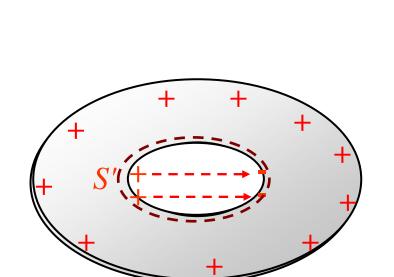
> 对于空腔导体内取高斯面,有

$$\therefore \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \qquad \therefore \sum q_{i} = 0$$

- ——电荷只能分布在表面上
- > 对于空腔的内表面,有

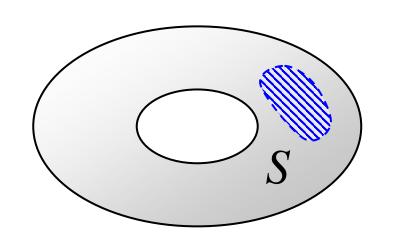
> 若内表面带等量异号的电荷,则

$$U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$



——与"静电平衡状态的导体是等势体"相矛盾,故空腔的内表面不带电。 经验 突厥由无电费时 由表面无电

结论:空腔内无电荷时,内表面无电荷,电荷分布在外表面,且腔内无电场线



▲ 空腔内有电荷

$$\therefore \quad \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

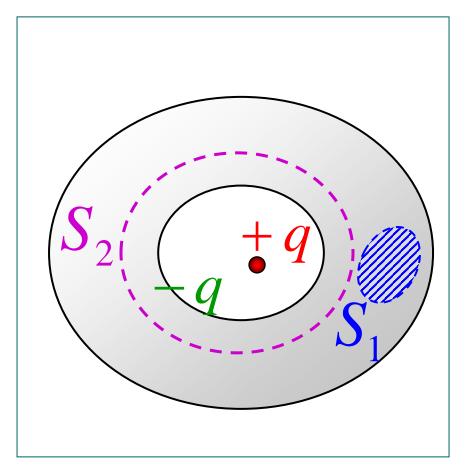
$$\therefore \sum q_i = 0$$

——电荷只能分布在表面上。

内表面上有电荷吗?

$$\therefore \quad \sum q_i = q_{\rm ph} + q = 0$$

$$\therefore q_{\bowtie} = -q$$



结论: 当空腔内有电荷+q时,内表面因静电感应出现等量异号的电荷-q,外表面同时出现等量同号的感应电荷+q。

3. 导体表面电场强度与电荷面密度的关系

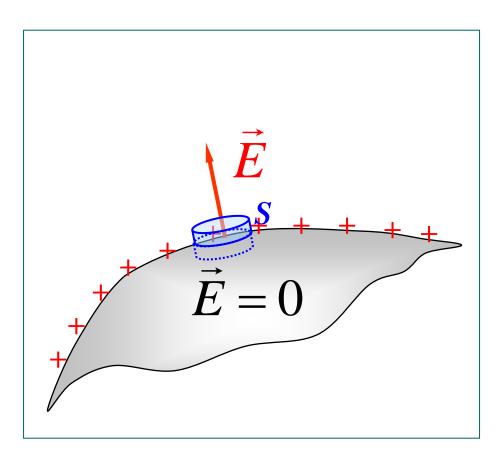
作圆柱形高斯面 S ,使其一个底在导体内。

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma S_{\mathbb{R}}}{\varepsilon_{0}}$$

 σ 为表面电荷面密度

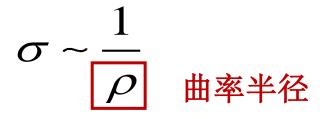
$$ES_{oxed{\mathbb{K}}}=rac{\sigma S_{oxed{\mathbb{K}}}}{oldsymbol{arepsilon}_{0}}$$

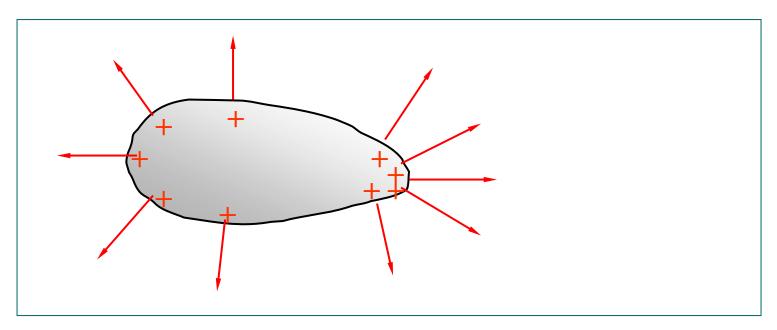
$$\therefore \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



结论:导体表面附近某处的电场强度大小与该处表面电荷面密度成正比。

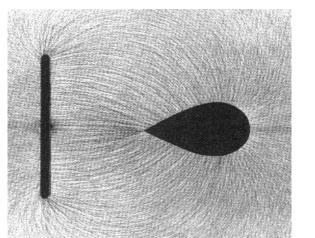
4. 导体表面电荷密度与导体表面曲率的关系



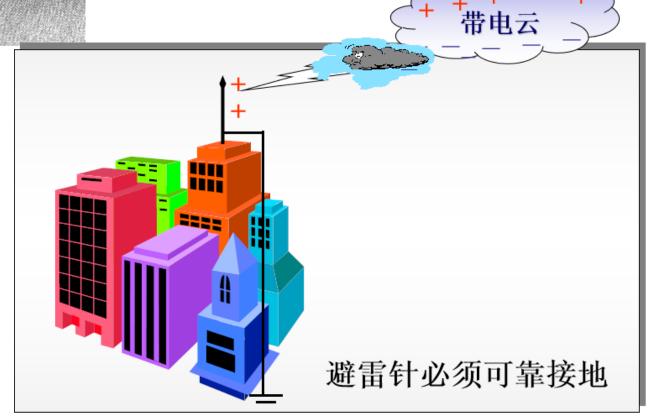


→ 导体表面电荷分布密度与导体表面的曲率半径成反比。

▲ 尖端放电现象

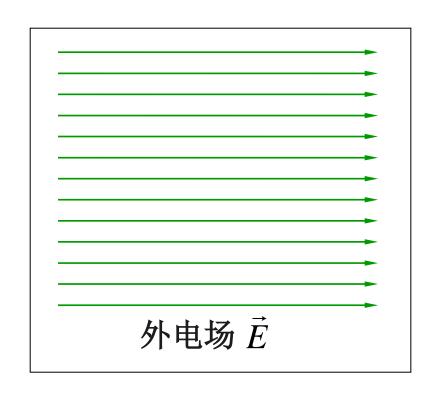


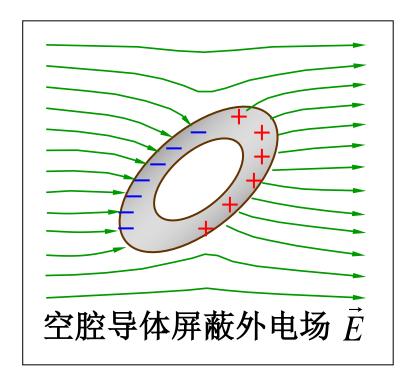
带电导体尖端附近的电场特别大,可使尖端附近的空气发生电离而成为导体产生放电现象.



5. 静电屏蔽

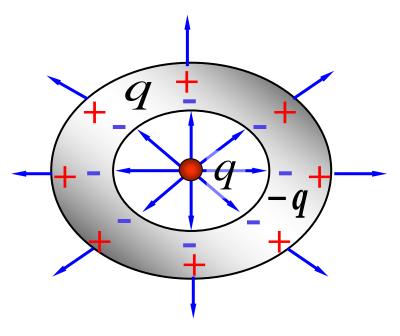
(1) 屏蔽外电场

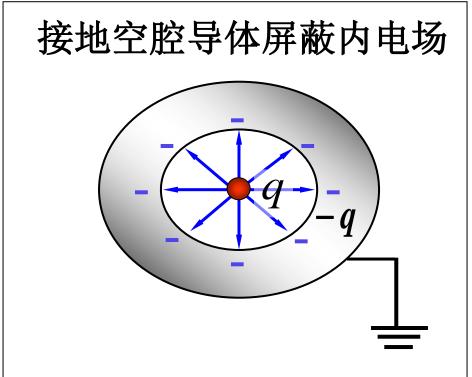




结论:空腔导体可以屏蔽外电场,使空腔内物体不受外电场影响。此时,整个空腔导体和腔内的电势处处相等。

(2) 屏蔽腔内电场





结论:接地空腔导体将使外部空间不受空腔内的电场影响。

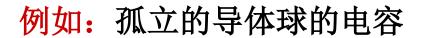
综合以上两种情形可知:一个接地的封闭导体壳,可以起到<u>壳内外互不影响</u>的屏蔽作用。

三、孤立导体的电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

单位: 法拉(F)

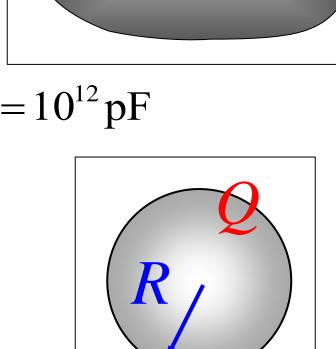
$$1F = 1C/V$$
 $1F = 10^6 \mu F = 10^{12} pF$



$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}} = 4\pi\varepsilon_0 R$$

♣ 若是地球大小, $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, 则

$$C \approx 7 \times 10^{-4}$$
 F ——很小!



四、电容器

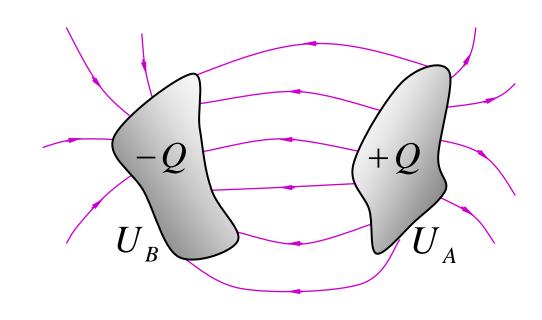
电容器由两个导体极板构成,串接在 电路中,彼此带有等量异号的电荷。

以 一 符号表示。

电容器的电容

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{Q}{\Delta U}$$

$$\Delta U = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



电容器电容的大小仅与导体的形状、相对位置、其间的电介质有关。与所带电荷量无关。